

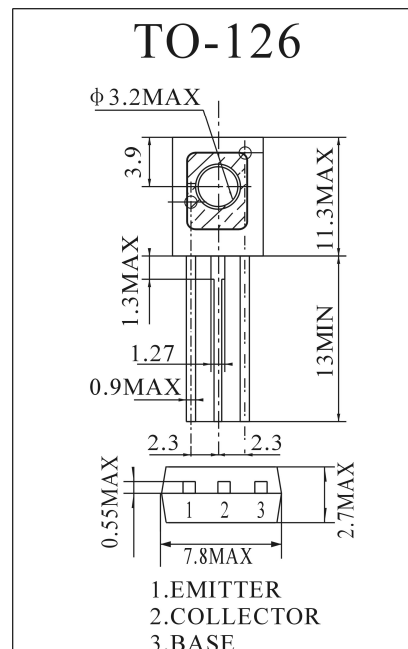
广东省粤晶高科股份有限公司

■■主要用途：功率放大。

■■绝对最大额定值（ $T_a=25^{\circ}\text{C}$ ）

项 目	符 号	额定值	单 位
集电极—基极电压	V_{CBO}	40	V
集电极—发射极电压	V_{CEO}	30	V
发射极—基极电压	V_{EBO}	5	V
集电极电流	I_{C}	3	A
集电极耗散功率	P_{C}	1	W
结 温	T_{J}	150	$^{\circ}\text{C}$
存储温度	T_{stg}	- 55~150	$^{\circ}\text{C}$

D882
—NPN silicon—



■■电参数（ $T_a=25^{\circ}\text{C}$ ）

项 目	符 号	最小值	典型值	最大值	单位	测 试 条 件
直流电流增益	h_{FE}	60		400		$V_{\text{CE}}=2\text{V}$, $I_{\text{C}}=1\text{A}$
集电极-基极截止电流	I_{CBO}			1	μA	$V_{\text{CB}}=30\text{V}$, $I_{\text{E}}=0$
发射极-基极截止电流	I_{EBO}			1	μA	$V_{\text{EB}}=3\text{V}$, $I_{\text{C}}=0$
集电极-基极击穿电压	BV_{CBO}	40			V	$I_{\text{C}}=1\text{mA}$, $I_{\text{E}}=0$
集电极-发射极击穿电压	BV_{CEO}	30			V	$I_{\text{C}}=10\text{mA}$, $I_{\text{B}}=0$
发射极-基极击穿电压	BV_{EBO}	3			V	$I_{\text{E}}=1\text{mA}$, $I_{\text{C}}=0$
集电极-发射极饱和压降	$V_{\text{CE(sat)}}$		0.3	1.5	V	$I_{\text{C}}=2\text{A}$, $I_{\text{B}}=0.2\text{A}$
基极-发射极饱和压降	$V_{\text{BE(sat)}}$		1.0	2.0	V	$I_{\text{C}}=2\text{A}$, $I_{\text{B}}=0.2\text{A}$
电流增益-带宽乘积	f_{T}		90		MHz	$I_{\text{C}}=100\text{mA}$, $V_{\text{CE}}=5\text{V}$
共基极输出电容	C_{ob}		45		PF	$V_{\text{CB}}=10\text{V}$, $I_{\text{E}}=0$, $f=1\text{MHz}$

■■ h_{FE} 分档及其标志

打印标识

分 档	R	Q	P	E
h_{FE}	60~120	100~200	160~320	200~400